

## 2П103А, 2П103Б, 2П103В, 2П103Г, 2П103Д

Транзисторы 2П103А, 2П103Б, 2П103В, 2П103Г, 2П103Д кремниевые диффузионно-планарные полевые с затвором на основе р-п перехода и каналом р-типа.

Предназначены для применения во входных каскадах усилителей низкой частоты и постоянного тока с высоким входным сопротивлением.

Транзисторы выпускаются в металлотеклянном корпусе с гибкими выводами.

Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 1 г.

Тип корпуса: КТ-1-7 (ТО-18).

Технические условия: ТФЗ.365.000 ТУ.

### Характеристики полевых транзисторов с р-п переходом и каналом р-типа 2П103А, 2П103Б, 2П103В, 2П103Г, 2П103Д:

Тип полевого транзистора	Предельные значения параметров при T=25°C					Значения параметров при T=25°C								T <sub>окр</sub>  °C
	P <sub>макс</sub> с	U <sub>си</sub> макс с	U <sub>зс</sub> макс с	U <sub>зи</sub> макс с	I <sub>с</sub> макс с	U <sub>зи</sub> отс	g <sub>22и</sub>	I <sub>з</sub> ут	S	I <sub>с</sub> нач	C <sub>11</sub> и	C <sub>12</sub> и	K <sub>ш</sub>	
	мВт	В	В	В	мА	В	мкС м	н А	мА/В	мА	пФ	пФ	дБ	
2П103А	120	10	15	10	-	0,5...2, 2	<40	10	0,7...2, 1	0,55...1, 2	<17	<8	3	- 60...+8 5
2П103Б	120	10	15	10	-	0,8...3	<50	10	0,8...2, 6	1...2,1	<17	<8	3	- 60...+8 5
2П103В	120	10	15	10	-	1,4...4	<80	10	1,4...3, 5	1,7...3, 8	<17	<8	3	- 60...+8 5
2П103Г	120	10	17	10	-	2...6	<130	10	1,8...3, 8	3...6,6	<17	<8	3	- 60...+8 5
2П103Д	120	10	17	10	-	2,8...7	<160	10	2,0...4, 4	5,4...12	<17	<8	3	- 60...+8 5

#### Условные обозначения электрических параметров полевых транзисторов:

- P<sub>макс</sub> - максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность полевого транзистора.
- U<sub>си макс</sub> - максимально допустимое напряжение сток-исток.
- U<sub>зс макс</sub> - максимально допустимое напряжение затвор-сток.
- U<sub>зи макс</sub> - максимально допустимое напряжение затвор-исток.
- I<sub>с макс</sub> - максимально допустимый ток стока полевого транзистора.
- U<sub>зи отс</sub> - напряжение отсечки полевого транзистора. Напряжение между затвором и истоком транзистора с р-п переходом или с изолированным затвором, работающего в режиме обеднения, при котором ток стока достигает заданного низкого значения.

- $g_{22и}$  - активная составляющая выходной проводимости полевого транзистора в схеме с общим истоком.
- $I_{зут}$  - ток утечки затвора. Ток затвора при заданном напряжении между затвором и остальными выводами, замкнутыми между собой.
- $S$  - крутизна характеристики полевого транзистора. Отношение изменения тока стока к изменению напряжения на затворе при коротком замыкании по переменному току на выходе транзистора в схеме с общим истоком.
- $I_{снач}$  - начальный ток стока. Ток стока при напряжении между затвором и истоком, равном нулю, и при напряжении на стоке, равном или превышающем напряжение насыщения.
- $C_{1и1}$  - входная ёмкость полевого транзистора. Ёмкость между затвором и истоком при коротком замыкании по переменному току на выходе с общим истоком.
- $C_{1и2}$  - проходная ёмкость полевого транзистора. Ёмкость между затвором и стоком при коротком замыкании по переменному току на входе в схеме с общим истоком.
- $Kш$  - коэффициент шума транзистора.
- $T_{окр}$  - температура окружающей среды.